



Toshiba lance des MOSFET 40V et 60V, basés sur la dernière génération de procédé "Trench"

La série U-MOS-IX-H 40V et 60V en boîtier DPAK, présente une $R_{DS(ON)}$ extrêmement faible pouvant descendre à 3.1 m Ω

Düsseldorf, Allemagne, 16 octobre 2017 – Toshiba Electronics Europe a annoncé de nouveaux MOSFET de puissance 40V et 60V, basés sur le dernier procédé semiconducteur "Trench", U-MOS-IX-H, de la société.

Les MOSFET canal-N, TK3R1P04PL, TK4R4P06PL et TK6R7P06PL, peuvent être pilotés par des niveaux logiques 4.5V et présentent des valeurs de résistance à l'état passant ($R_{DS(ON)}$) maximum ultra-faibles, pouvant descendre à 3.1 m Ω (à $V_{GS} = 10V$). Fournis en boîtier DPAK, ces dispositifs sont parfaits pour les applications de conversion d'énergie haut-rendement, notamment les convertisseurs CA-CC ou CC-CC, les alimentations et les commandes moteur.

Le TK3R1P04PL est un MOSFET 40V avec une $R_{DS(ON)}$ maximum de 3.1 m Ω et un courant de drain (I_D) maximum de 58A (à 25°C). Les TK4R4P06PL et TK6R7P06PL 60V ont des valeurs $R_{DS(ON)}$ et I_D maximum de respectivement 4.4 m Ω et 58A, et 6.7 m Ω et 46A.

Tous ces nouveaux MOSFET sont conçus pour fonctionner avec une faible charge en sortie, afin d'optimiser encore le rendement et les performances.

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Press Release

###

A propos de Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe](#) (TEE) est la division européenne de composants électroniques de [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#). TEE offre aux consommateurs et aux entreprises européennes un large choix de disques durs (HDD) et de semiconducteurs innovants pour les applications automobiles, industrielles, IoT (Internet of Things, ou Internet des objets), de contrôle d'axe, de télécommunications, de réseaux, de grand-public ou d'électro-ménager. Le large catalogue de la société comprend des CI sans-fil, des semiconducteurs de puissance, des microcontrôleurs, des semiconducteurs optiques, des ASIC (circuits intégrés spécifiques), des ASSP et des dispositifs discrets allant de diodes à des CI logiques.

Fondé en 1973 à Neuss en Allemagne, TEE a son siège à Düsseldorf en Allemagne, et possède des filiales en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, assurant la conception, la fabrication, le marketing et les ventes. Le président de la société est M. Akira Morinaga. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Toshiba Electronics Europe : www.toshiba.semicon-storage.com.

Personne à contacter pour les questions concernant la publication:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

E-mail: discrete-ic@toshiba-components.com

Pour des informations concernant la publication, contactez:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)193 282 2832

E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Publié par:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

Web: www.publitek.com

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Octobre2017

Réf : 7079/A